АСТРОФИЗИКА

TOM 61

МАЙ, 2018

ВЫПУСК 2

ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОСФЕРЫ НА ВЫШЕЛЕЖАЩИЕ СЛОИ АТМОСФЕРЫ ЗВЕЗДЫ

О.М.БЕЛОВА¹, К.В.БЫЧКОВ² Поступила 22 ноября 2017 Принята к печати 7 марта 2018

На примере атома водорода исследовано влияние тенлового излучения фотосферы на расположенные выше слои. Показано, что при температуре излучения выше 5000 К скорости вынужленных процессов при своболно-связанных, связанно-связанных и свободно-свободных переходах сравнимы с соответствующими скоростями спонтанных процессов. Существенную ронь играют также фотовозбуждение и фотонопизация из возбужленных состояний.

Ключевые слова: вынужденные процессы: фотоионизация: звездные атмосферы

1. Введение. В предлагаемой работе мы опениваем влияние излучения фотосферы на пропессы ионизации, рекомбинации, возбужления вышележащих слоев газа и их тормозного излучения.

Во-первых, такими слоями могут быть хромосферы Солнца и звезд спектральных классов G-M в спокойных условиях или во время вспышки. Температура спокойной фотосферы *T*, лежит в диацазоне от 3000 K до 7000 K, а в случае вспышки в ней может образоваться горячее пятно с температурой (10000 + 20000 K). Вгоwп [1], Костюк и Пикельнер [2] при исследовании солнечных вспышек, пользуясь модифицированной формулой Саха, учли фотононизацию водорода со вгорого уровня излучением фотосферы в бальмеровском континууме. Гринин и Катышева [3,4] впервые показали важность учета ионизации фотосферным излучением из возбужденных состояний водорода в околозвездных оболочках. Температуру фотосферы авторы приняли равной 5000 K, типичной для звезд типа T Tauri. Кацова и др. [5] рассмотрели рассеяние излучения в частотах линии Ly α . Более поздние газодинамические NLTE-расчеты [6] учитывают процессы ионизации, возбуждения, деактивации и рекомбинании в 6-уровневом атоме водорода с учетом рассеяния в линиях.

Во-вторых, в пульсирующих звездах - цефеидах, долгопериодических переменных типа Миры Кита и полуправильных переменных - над фотосферой может находиться вызванная пульсациями ударная волна. Расчеты высвечивания газа за фронтом ударной волны для условий в холодных звездах (*T* = 3000 K) выполнены в работах [7,8] с учетом четырех уровней, а также

в [9] в модели 25-уровневой системы. Результаты работы [8] использовали Gillet&Fokin [10] для случая звезд типа RR Lyrae (T_{\star} = 7000 K). Во всех этих статьях фотосферное излучение не учитывалось.

Ниже мы изложим результаты расчетов, позволяющих выяснить, в каких случаях влиянием фотосферы действительно можно пренебречь, а при каких оно оказывается существенным. Излучение фотосферы рассматриваем в рамках модели черного тела. Отсутствие излучения, илущего сверху вниз, учитываем фактором дилющии W = 0.5. Полагаем, что налфотосферный газ состоит из чистого водорода. В разделах 2, 3 и 4 оценен вклад выпужденных процессов в коэффициент фоторекомбинации, в моншость рекомбинационных и тормозных потерь. В 5-м разделе рассмотрены роль фотоионизации из возбужденных состояний и фотовозбуждение субординатных переходов, в 6-м - бальмеровский декремент.

2. Коэффициент вынужденной фоторекомбинации. Ссчения вынужденной s⁽ⁱ⁾ и спонтанной s⁽ⁱ⁾ фоторекомбинации связаны известным соотношением

$$s^{(l)} = s^{(x)} \cdot n_{m}$$
. (1)

Здесь *n*_∞ - число заполнения фотонов, в случае дилютированного поля теплового излучения равное

$$n_{\omega} = \frac{W}{e^{hv/k_{g}T_{e}} - 1},$$
(2)

где *Т*. - температура излучения. В случае агома водорода сечение спонтанной фоторекомбинации на дискретный уровень с главным квантовым числом *k* выражается через сечение фотоиопизации [11]:

$$s_k^{(s)} = \sigma_k \frac{\alpha^2}{2} k^2 \left(\frac{h\nu}{Ry}\right)^2 \frac{Ry}{E},$$
(3)

которос в приближении Крамерса имеет вид [11]:

$$\sigma_k = \frac{64}{3\sqrt{3}} \alpha \pi a_0^2 \frac{1}{k^5} \left(\frac{\mathrm{Ry}}{h\nu}\right)^3. \tag{4}$$

Коэффициент вынужденной фоторскомбинации $r_k^{(t)}$ получается суммированием по всем возможным значениям скорости свободного электрона *и* произведения $s_k^{(t)}u$ с учетом распределения электронов по энергии *E*:

$$r_k^{(r)} = \int_0^\infty s_k^{(r)} u \cdot f(E) dE.$$
 (5)

Для функции распределения пользуемся формулой Максвелла:

$$f(E) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (k_B T_e)^{-3/2} \sqrt{E} \cdot e^{-2/k_B T_e} .$$
 (6)

Полставляя в (5) формулы (1)-(4) и (6), получаем:

$$r_{k}^{(1)} = \int_{0}^{\pi} S_{k}^{(s)} n_{\omega} u f(E) dE = \frac{64}{3\sqrt{3\pi}} \frac{W}{k^{3}} \alpha^{4} \pi a_{0}^{2} c \cdot \beta_{k}^{3/2} e^{\beta_{k}} \cdot J_{1}(\rho, b_{k}).$$
(7)

Здесь введсны обозначения:

$$\beta_{k} = \frac{1}{k^{2}} \frac{Ry}{k_{B}T_{e}}, \quad b_{k} = \frac{1}{k^{2}} \frac{Ry}{k_{B}T_{e}}, \quad \rho = \frac{T_{e}}{T_{e}}, \quad J_{1}(x, y) = \int_{y}^{\infty} \frac{e^{-xt}}{t(e^{t}-1)} dt.$$

Апторитм вычисления интеграла J_1 приведен в разделе 8. Если в подынтегральной функции (7) исключить множитель n_{∞} , то мы получим известное определение коэффициента спонтанной рекомбинации

$$r_k^{(s)} = \int_0^\infty s_k^{(s)} u f(E) dE ,$$

в принятом нами приближении равный

$$r_{k}^{(s)} = \frac{64}{3\sqrt{3\pi}} \frac{W}{k^{3}} \alpha^{4} \pi a_{0}^{2} c \cdot \beta_{k}^{3/2} e^{\beta_{k}} \cdot \mathrm{Ei}_{1}(\beta_{k}),$$

где Ei₁(β_k) - интегральная показательная функция.



Рис.1. Отношение $R_{\rm c}$ коэффициентов вынужденной и спонтанной рекомбинации при грех значениях температуры излучения $T_{\rm c}$: I - 3000 K, II - 6000 K, III - 10000 K, IV - 20000 K; систошные кривые соответствуют электронной температуре 6000 K, штриховые - 10000 K; во врезке - графики I-III для уровней k = 3 + 7.

На рис.1 показано отношение $R_k = r_k^{(t)}/r_k^{(s)}$ как функция главного квантового числа *k* для различных температур излучения и газа. Верхнюю границу $K_{\rm ff}$ определяем по критерию Инглиса-Теллера [12] через электронную плотность N_e , выраженную в см⁻³:

$$K_{\rm IT} = 3.10 - 0.13 \lg(2 N_e).$$

В случае атмосфер звезл-гигантов величину N_e примем равной 10⁻² см⁻¹, ей соответствует K_{II} = 25; для карликов, соответственно N_e = 10¹⁴ см⁻³ и K_{II} = 13.

Для основного и первого возбужленного состояний (k < 3) в рассматриваемом диапазоне *T*. ≤ 20000 К вынужденная рекомбинания относительно невелика. Ее вклад становится существенным у более высоких уровней. Например, вклад 25% при *T*. = 20000 К дает рекомбинация уже на третий уровень, а при *T*. = 10000 К - на пятый. В звездах спектрального класса G, которым соответствует *T*. = 6000 К, областью заметного влияния вынужленной рекомбинации (R > 20%) является k > 5. В случае звезд класса M (T = 3000 К) вынужденная рекомбинация пренсбрежимо мала вплоть до k = 12. Как нами показано в работе [13], тройная рекомбинация начинает доминировать уже при k = 10, т.е., для звезд класса M вынужденную рекомбинацию учитывать не обязательно. Таким образом, вынужденная фоторекомбинация существенна при *T*. > 5000 К в диапазоне значений главного квантового числа 3 < k < 10.

3. Вклад в рекомбинационное излучение. Коэффициент интегрального по частоте излучения ε_k при рекомбинации на k-й уровень в расчете на одну пару "ион-электрон" получается при включении излучаемой энергии $h \vee B$ подынтегральную функцию:

$$\varepsilon_k^{(s,i)} = \int_0^\infty s_k^{(s)} u \cdot h \, v \left\{ \begin{matrix} 1 \\ n_\omega \end{matrix} \right\} f(E) \, dE \, .$$

По аналогии с предыдущим разделом приходим к формулам

$$\varepsilon_{k}^{(s)} = \frac{64}{3\sqrt{3\pi}} \alpha^{4} \pi a_{0}^{2} c \cdot \text{Ry} \cdot \frac{\sqrt{\beta_{k}}}{k^{2}},$$

$$\varepsilon_{k}^{(i)} = \frac{64}{3\sqrt{3\pi}} \alpha^{4} \pi a_{0}^{2} c \cdot \frac{\beta_{k}^{3/2}}{k^{2}} k_{B} T \cdot e^{\beta_{1}} \cdot \text{W} \cdot J_{0}(\rho, b_{k}),$$
(8)

гле

5

$$J_0(x, y) = \int_{y}^{\infty} \frac{e^{-xt}}{e^t - 1} dt.$$

Алгоритм вычисления интеграла J, приведен в Приложении.

Относительный вклал вынужденного излучения характеризуем отношением $\rho_* = \epsilon_1^{(j)} / \epsilon_*^{(j)}$, которое приведено на рис.2. Как и в прелыдущем разделе, этот

ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОСФЕРЫ НА ВЕРХНИЕ СЛОИ 259

вклал при фиксированной температуре возрастает с номером уровня, оставаясь пренебрежимо малым при $T_c = 3000$ K. Его величина достигает 20%, начиная с сельмого уровня для $T_c = 6000$ K. пятого - для $T_c = 10000$ K и третьего - для $T_c = 20000$ K.



Рис.2. Отношение мошности радиационных потерь при вынужленной и спонтанной рекомбинании; обозначения кривых соответствуют рис.1.

4. Тормозное излучение. Сечение спонтанного тормозного излучения с⁽¹⁾ в расчете на сдиницу линейной частоты и на пару электрон-протон в приближении Крамерса [11] равно

$$\varsigma_{\nu}^{(z)} = \frac{h}{\mathrm{Ry}} \frac{16}{3\sqrt{3}} \alpha^3 \pi a_0^2 \left(\frac{\mathrm{Ry}}{E}\right) \left(\frac{\mathrm{Ry}}{h\nu}\right).$$

Спектральная мощность излучения $\varepsilon_v^{(6)}$ получается интегрированием скорости потери энергии по всем возможным значениям энергии электрона в диапазоне E > hv:

$$\varepsilon_{v}^{(g)} = \int_{h_{v}}^{\infty} \varsigma_{v}^{(x)} u \cdot h v \cdot f(E) dE = h \frac{32}{3\sqrt{3\pi}} \alpha^{4} \pi a_{0}^{2} c \cdot \sqrt{\frac{Ry}{k_{B}T_{e}}} \cdot e^{-k v/k_{B}T_{e}} .$$

Сечение выпужденного излучения $\varsigma_{v}^{(i)}$, как и в случае рекомбинации, равно произведению $\varsigma_{v}^{(s)} n_{\omega}$. Множитель n_{ω} не зависит от энергии электронов, поэтому для спектральной мощности имеем:

$$\varepsilon_{v}^{(fi)} = \varepsilon_{v}^{(fi)} \cdot n_{\omega} = W \cdot h \frac{32}{3\sqrt{3\pi}} \alpha^{4} \pi a_{0}^{2} c \cdot \sqrt{\frac{\mathrm{Ry}}{k_{B}T_{e}}} \cdot \frac{e^{-hv/k_{B}T_{e}}}{e^{hv/k_{B}T_{e}} - 1}.$$

Полные тормозные потери получаются в результате интегрирования по всему дианазону частот. Коэффициент спонтанного излучения равен

$$\varepsilon^{(f_2)} = \frac{32}{3\sqrt{3\pi}} \alpha^4 \pi a_0^2 c \cdot \operatorname{Ry} \sqrt{\frac{k_B T_e}{\operatorname{Ry}}}.$$

В случае лиспотированного теплового поля излучения интеграл, описывающий вклад вынужденного излучения, логарифмически расходится на нижнем пределе. Поэтому введем отличную от нуля минимальную частогу v_{run}. Тогда имеет место формула, аналогичная (8):

$$\varepsilon^{(n)} = \frac{32}{3\sqrt{3\pi}} \alpha^4 \pi a_0^2 c \cdot k_B T_{\bullet} \cdot W \cdot J_0(\rho, \gamma_{\bullet}), \qquad (9)$$

гле

 $\gamma_* = \frac{h v_{\rm mm}}{k_B T_*}.$

Соответственно, полный коэффициент тормозного излучения равен

$$\varepsilon^{(f)} = \varepsilon^{(f_{0})} + \varepsilon^{(f_{0})} = \frac{32}{3\sqrt{3\pi}} \alpha^{4} \pi a_{0}^{2} c \cdot \operatorname{Ry} \sqrt{\frac{k_{B}T_{e}}{\mathrm{Ry}}} \cdot \left[1 + F_{\mathrm{ind}}\right],$$

где

$$F_{\text{ind}} = W \cdot \frac{T_*}{T_e} \cdot J_0(\rho, \gamma_*).$$

Величина *F*_{ind} равна отношению мощностей вынужденного и спонтанного излучения.

Нижний предел hv_{min} принимаем равным частоте, на которой возмущенный газ становится непрозрачным по тормозному излучению:

$$\tau_{ff}(\mathbf{v}_{\min}) = 1. \tag{10}$$

Болышая точность в определении частоты v_{min} не нужна в силу того, что зависимость интеграла от нее только логарифмическая. В лиапазоне частот $v < v_{min}$ вынужденное излучение при необходимости учитываем обычным нутем, следуя закону Кирхгофа.

Коэффициент тормозного поглощения вычисляем по формуле

$$\kappa_{\varphi}^{(g')} = \frac{256}{3\sqrt{3}} \alpha \pi^{5/2} a_0^5 \left(\frac{\mathrm{Ry}}{h_V}\right)^3 \sqrt{\frac{\mathrm{Ry}}{k_B T_e}} N_e N_f \,.$$

Сечение поглощения в центре линии Ly а атома водорода равно

$$\sigma_{12} = 4\pi^{3/2} a_0^2 \sqrt{\frac{M_{\rm H}}{m_e}} \frac{\rm Ry}{E_{12}} f_{12} \sqrt{\frac{\rm Ry}{k_B T_{ai}}},$$

гле M_{H} и m_{e} - массы, соответственно, атома водорода и электрона, f_{12} - сила

оспиллятора в поглощении, E_{11} - энергия перехода. Найдем отношение о оптических глубин по тормозному поглощению $\tau_{ff}(v)$ на частоте v и в липии Ly α :

$$\mathbf{U} = \frac{\tau_{g}(\mathbf{v})}{\tau_{\mathrm{Lya}}} = \frac{\mathbf{\kappa}_{e}^{(g)}}{\sigma_{\mathrm{L}2} N_{\mathrm{I}}} = \frac{64\pi}{3\sqrt{3}} \frac{\alpha a_{0}^{2}}{f_{12}} \cdot \sqrt{\frac{m_{e}}{M_{\mathrm{H}}}} \cdot \frac{E_{12}}{\mathrm{Ry}} \cdot \sqrt{\frac{T_{z}}{T_{e}}} \cdot \left(\frac{\mathrm{Ry}}{h_{\mathrm{V}}}\right)^{3} \frac{N_{e}N_{e}}{N_{1}}.$$

Величину v_{min} , исходя из условия (10), выражаем через оптическую глубину в линии Ly α :

$$\frac{h v_{\min}}{\text{Ry}} = \sqrt[3]{\frac{64\pi\alpha}{3\sqrt{3} f_{12}}} \cdot a_0 \cdot \sqrt[6]{\frac{m_e}{M_H}} \sqrt[3]{\frac{E_{12}}{\text{Ry}}} \cdot \sqrt[6]{\frac{T_{ai}}{T_e}} \cdot \sqrt[3]{\frac{N_e N_i}{N_1}} \tau_{\text{Ly}\alpha} \approx 1.5 \cdot 10^{-3}$$

Как видно из последней формулы, искомая частога слабо зависит от нараметров высвечивающегося газа. Оптическую глубину в линии Ly α взяли из расчетов высвечивания ударной волны, $\tau_{Ly\alpha} \approx 10^5$. Мы приняли температуры равными, $T_{-} = T_{c} \approx 20000$ K, а степень ионизании газа - половине: $N = N = N_1$. Таким образом, получаем оненку для γ_{-} :

$$\gamma_{*} = \frac{h v_{\text{min}}}{\text{Ry}} \frac{\text{Ry}}{k_{B} T_{*}} \approx 1.5 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Ry}}{k_{B} T_{*}}.$$

В последней строке табл. 1 приведены значения величины F_{mat} . Итак, в случае тормозного излучения вклад выпужденных процессов в охлаждение сравним с вкладом спонтанного излучения.

Таблица 1

ВКЛАД ВЫНУЖДЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СКОРОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ СВОБОДНО-СВОБОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ

T., K 3000		6000	10000	20000	
Y .	0.08	0.04	0.02	0.01	
$J_{\rho}(\rho,\gamma_{*})$	2.45	2.89	3.18	3.46	
F	0.2	0.4	0.8	1.7	

5. Фотононизация из возбужденных состояний и фотовозбуждение субординатных переходов. Скорость фотононизации тепловым излучением также вычисляем в приближении Крамерса:

$$\Phi_{k}(T,)=4\pi W\int_{v_{k}}^{\infty}\sigma_{k}^{(ph)}\frac{B(T)}{h\nu}d\nu=\frac{8}{3\pi\sqrt{3}}\frac{W}{k_{5}}\alpha^{4}\frac{c}{a_{0}}K_{1}(b_{k}), \quad k\geq 2,$$

где

$$K_1(y) = \int_{y}^{\infty} \frac{1}{t(e'-1)} dt.$$

Алгоритм расчета интеграла $K_1(y)$ с учетом расхолимости в точке y = 0 опубликован в [14]. Для сравнения скоростей фото- и уларной ионизации мы вволим величину ϕ_k , равную логарифму их отношения:

$$\varphi_k = \lg \left(\frac{\Phi_k(T_*)}{q_k(T_*)N_*} \right), \tag{11}$$

где q - коэффициент ионизации электропным ударом, вычисленный по формулам работы [15]. Графики о, приведены на рис.3, величина N принята равной 10^{12} см⁻³. Хорошо видно, что влияние фотоионизации существенно в случае состояний небольшого возбуждения, $2 \le k \le 7$, в то время как электронным ударом контролируется ионизация из высоковозбужденных состояний.



Рис.3. Логарифм отношения скорости фотоионизации и ударной ионизации для возбужденных состояний; обозначения кривых соответствуют рис.1.

Обраннающий слой звезд спектральных классов M-G не сильно поглощает излучение в частотах линий бальмеровской серии, поэтому температуру излучения и в этом случае можно принять равной температуре фотосферы. Скорость фотовозбуждения Φ_{la} с нижнего уровня / на верхний *и* в расчете на один атом на нижнем уровне равна

$$\Phi_{lu}(T_*) = W \cdot n_{\omega}(T_*) \cdot B_{lu} ,$$

пе коэффициент Эйнштейна B_{μ} выражается через вероятность спонтанного перехода A_{μ} и статистические веса уровней $g_{\mu}g_{\mu}$:

$$B_{lu} = \frac{g_u}{g_l} A_{ul} \, .$$

ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОСФЕРЫ НА ВЕРХНИЕ СЛОИ 263

Аналогично (11) для линий бальмеровской серии составляем логарифм отполіения

$$\Psi_k = \lg \left(\frac{\Phi_{2k}(T_*)}{q_{2k}(T_*)N_*} \right),$$

в котором q_{\perp} - коэффициент ударного возбужления, рассчитанный по формуле из работы [15]. Как показывают графики рис.4, фотовозбужление является существенным фактором для звезд класса G и горячее. Величина ψ_{\perp} как функция главного квантового числа k асимптотически стремится к некоторому консчному значению. Это объясняется тем, что при высоких значениях температуры коэффициент ударного возбуждения пропорционален силе оспиллятора в поглошении.



Рис.4. Логарифм отношения скорости фотовозбужления и ударного возбуждения в линиях бальмеровской серии: обозначения кривых соогветствуют рис.1.

6. Бальмеровский декремент. Степень влияния фотосферы на вышележащие слои зависит не только от се температуры T_{a} , по и от нараметров самих слоев - T и N_e . При $N < 10^{12}$ см⁻³ газ прозрачен в линиях бальмеровской серии, и в первом приближении можно не учитывать ударные переходы между возбужденными состояниями. С увеличением плотности возрастает роль уларных процессов, и при $N = 10^{13}$ см⁻³ может возникнуть самопоглощение в линиях бальмеровской серии. Введем обозначения N_p , N_k и N_a , соответственно, для концентрации протонов, атомов водорода на k-м уровне и полной концентрации атомов:

$$N_{\mu} = \sum_{k=1}^{K_{\mu}} N_{k} \,. \tag{12}$$

Полную концентрацию водорода обозначим N_#

$$N_{\rm H} = N_a + N_p \,. \tag{13}$$

Считаем выполненным условие электронейтральности. Для чисто водородной среды оно имсет вил:

$$N_e = N_p$$
.

6.1. Газ, прозрачный в линиях бальмеровской серии. Здесь мы полагаем, что заселение уровней с k = 3 до $k = K_{II}$ происходит путем рекомбинации и возбуждения электронным ударом из основного состояния, а также разиационными переходами с более высоких уровней. Такая постановка задачи имеет некоторое сходство с расчетами рекомбинационного излучения межзвездного газа, но здесь мы рассматриваем все три канала рекомбинации: спонтанную, вынужденияю и безызлучательную.

Результаты расчетов бальмеровского декремента приведены на рис.5 для следующих параметров газа: $T_e = 10000$ K, $N_e = 10^{12}$ см⁻¹. Сплошная кривая построена без учета вынужденных переходов. Немонотонная зависимость интенсивности спектральных линий от квантового числа верхнего уровня k объясняется влиянием тройной рекомбинации, причем положение минимума



Рис.5. Бальмеровский декремент без самоноглощения в линиях субординатных переходоа: штриховые кривые - с учетом выпужленных процессов, сплошная кривая - без учета; обозначения штриховых кривых соответствуют рис.1.

зависит от электронной плотности. Четыре штриховые кривые соответствуют разным значениям температуры излучения. Во всех случаях влияние выпужленного излучения проявляется у достаточно высоких членов серии, начипая с Н ζ .

6.2. Самопоглощение в первых членах бальмеровской серии. Хромосферный газ в станионарных условиях, как правило, прозрачен в линиях бальмеровской серии. Но нестанионарное охлаждение за фронтом ударной волны сопровождается появлением слоя сильно нагрегого (T > 15000 K) и слабо нонизованного водорода (x < 0.5). Он может оказаться непрозрачным в частотах первых четырех линий бальмеровской серии. Мы приняли $T_e = 10000$ K, $N_{\rm H} = 10^{11}$ см⁻³, T = 20000 K. Толшину слоя L положили равной 300 км. (Обычно размеры возмущенных областей значительно меньше, но в модельных расчетах эта величина позволяет имитировать нестационарные условия).

Относительные населенности лискретных уровней $v_k = N_k/N$ определялись одновременно с состоянием ионизании x путем решения системы уравнений баланса с учетом фотоиопизации, спонтанной и вынужденной фоторекомбинации, спонтанных и вынужденных радиационных переходов с учетом рассеяния в спектральных линиях, а также процессов под действием электронного удара: лискретных переходов q_* , ионизании и тройной рекомбинации γ_k

$$\left[\Phi_{k}(T_{*}) + q_{k}N_{e} + \sum_{k>i} \left(A_{ki}^{*} + \Phi_{ki}^{*} + q_{ki}N_{e} \right) + \sum_{k$$

Из формул (12) и (13) следует условие нормировки для у и х.

$$\sum_{k=1}^{n_{II}} \mathbf{v}_k + x = 1.$$

Знак "*" означает, что учтено рассеяние в частотах спектральных линий при вычислении скорости V_{ik} некоторого радиационного перехода между лискретными состояниями: $V_{ik}^* = V_{ik}/\zeta_{ik}$. Число рассеяний ζ_{ik} мы вычисляем по оптической глубине в центре линии τ_{ik} , используя модель Соболева-Бибермана-Холстейна для доплеровского и хольцмарковского контуров, расчетные формулы приведены в [9]. Оптическая глубина в центре линии выражается через сечение σ_{ik} , паселенность нижнего уровня, полную копцентрацию водорода и толщину слоя:

$$\tau_{ik} = \sigma_{ik} v_i N_H L.$$

Выпишем формулу для сечения поглощения в центре линии в приближении лоплеровского контура:

О.М.БЕЛОВА, К.В.БЫЧКОВ

$$\sigma_{ik} = 4\pi^{3/2} a_0^2 \sqrt{\frac{M_{\rm H}}{m_e}} \frac{{\rm Ry}}{E_{ik}} f_{ik} \sqrt{\frac{{\rm Ry}}{k_B T_{ai}}} \,.$$

Результаты расчетов приведены на рис.6. Сплопнюй кривой изображен бальмеровский декремент без учета излучения фотосферы. Как вилно из рисунка, при $T_{\star} \leq 8000$ К излучение практически не влияет на декремент, а при $T_{\star} \geq 10000$ К меняет результат примерно на 10-20%. Причиной является доминирование электронного удара над радиационными процессами.



Рис.6. Бальмеровский декремент в случае самопоглощения в линиях субординатных переходов: штриховые кривые - с учетом излучения фотосферы, сплошная кривая - без учета; обозначения штриховых кривых соответствуют рис.1

7. Заключение. Излучение фотосферы при T > 5000 К может оказывать влияние на состояние вышележащего газа путем вынужденных пропессов рекомбинации и тормозного излучения, а также путем фотоионизации и фотовозбуждения в частотах суборлинатных линий.

1. Относительный вклад вынужденной фоторекомбинации в полную скорость фоторекомбинации растет с номером уровня k, а при фиксированном значении k - по мере увеличения температуры излучения. Аналогичная ситуация имеет место и для потерь энергии при рекомбинационном излучении.

 Позная по спектру скорость энергетических потерь путем вынужленного тормозного излучения сравнима со спонтанным излучением при T_{*} > 5000 K.

3. Фотононизация наиболее эффективна в случае состояний среднего возбужления, $2 \le k \le 7$.

4. Скорость фотовозбужления в частотах линий бальмеровской серии при $T_s > 5000$ К может значительно превышать скорость ударного возбужления при $T_s = 10000$ К и $N_s = 10^{12}$ см⁻³.

 Излучение фотосферы существенно влияет на бальмеровский лекремент налфотосферного газа, прозрачного в линиях бальмеровской серии (N < 10¹² см⁻¹).

6. Бальмеровский лекремент плотного газа ($N > 10^{-4}$ см⁻³), не прозрачного в первых четырех линиях бальмеровской серии, практически не зависит от температуры излучения.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 15-03-03302 и гранта научной школы НШ 9670.2016.2.

ПРИЛОЖЕШИЕ

Алгоритм вычисления интегралов J_0 и J_r В обоих случаях алгоритм зависит от величины аргумента у. В лиапазоне

 $y \ge 1$

выполняем разложение по малому параметру e^{-y} . Интеграл J_0 представим в виле ряда:

$$J_0(x, y) = \int_y^\infty \frac{e^{-xt}}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^\infty \int_y^\infty e^{-(x+n)t} dt = e^{-xy} \sum_{n=1}^\infty \frac{e^{-ny}}{x+n},$$

сходимость которого обусловлена множителем *e^{-ny}*. Последнюю сумму нанишем в виде двух слагаемых:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-ny}}{x+n} = \Sigma_m^{(0)} + R_m^{(0)},$$

гле $\Sigma_m^{(0)}$ - конечная сумма:

$$\Sigma_m^{(0)} = \sum_{n=1}^m \frac{e^{-ny}}{x+n},$$

а $R_m^{(0)}$ - остаток, верхнюю границу которого получаем из неравенства $n \ge m+1$:

$$R_m^{(0)} = \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{e^{-ny}}{x+n} < \frac{1}{x+m+1} \sum_{n=m+1}^{\infty} e^{-ny} = \frac{e^{-(m+1)y}}{x+m+1} \frac{1}{1-e^{-y}}.$$

Интеграл J, раскладываем в ряд по интегральным показательным функциям:

$$J_1(x, y) = \int_{y}^{\infty} \frac{e^{-xt}}{e^t - 1} \frac{dt}{t} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{y}^{\infty} e^{-(x+n)t} \frac{dt}{t} = \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Ei}_1[(x+n)y].$$

Как и выше, представляем ряд в виде консчной суммы и остатка:

$$J_1(x, y) = \Sigma_m^{(1)} + R_m^{(1)},$$

гле

$$\Sigma_{m}^{(1)} = \sum_{n=1}^{m} \operatorname{Ei}_{1}[(x+n)y], \quad R_{m}^{(1)} = \sum_{n=m+1}^{n} \operatorname{Ei}_{1}[(x+n)y]. \quad (14)$$

Для определения верхней границы остатка воспользуемся неравенством

Ei:
$$(a) = \int e^{-at} \frac{dt}{t} < \int e^{-at} \frac{dt}{1} = \frac{e^{-a}}{a}$$
 (15)

Подставляя (15) в (14), получаем:

$$R_m^{(1)} < \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{e^{-(x+n)y}}{(x+n)y} < \frac{e^{-xy}}{(x+m+1)y} \sum_{n=m+1}^{\infty} e^{-ny} = \frac{e^{-(x+m+1)y}}{(x+m+1)y} \frac{1}{1-e^{-y}}.$$

Рассмотрим область малых значений аргумента у. Хотя оба ряда (14) и (15) сходятся при любых его положительных значениях, при $y \le 1$ требуется слишком много слагаемых. Это связано с расходимостью обоих интегралов на нижнем пределе. Разбиваем область интегрирования J_1 на три интервала:

$$J_i = I_1^{(i)} + I_{21}^{(i)} + I_3^{(i)} = \int_{y}^{m} + \int_{\infty}^{1} + \int_{1}^{1} ,$$

величину ϖ примем равной 0.2. Если $y > \varpi$, то первый интервал отсутствует. Интервал $y \ge 1$ рассмотрен выше, его вклад равен

$$I_3^{(i)} = J_i(x, 1).$$

Для *у* < • пользуемся разложением

$$\frac{t}{e^t-1}=\sum_{k=0}^{\infty}B_k\,\frac{t^k}{k!}\,,$$

где B_1 – числа Бернулли; оно позволяет получить аналитическое выражение лля интеграла. При выбранном значении ϖ достаточно сохранить слагаемые до $B_{10} t^{10}/10!$ включительно; выпишем необхолимые числа Бернулли:

k	0	1	2	4	6	8	10
B_{\pm}	1	-1/2	1/6	-1/30	1/42	-1/30	5/66

В интервале $\varpi < y < 1$ применяем метод Гаусса.

¹ Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия,

- e-mail: whitecanvas05122010@mail.ru
- ² Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Астрономический институт им. П.К.Штернберга, Москва, Россия, e-mail: bychkov@sai.msu.ru

ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОСФЕРЫ НА ВЕРХНИЕ СЛОИ 269

INFLUENCE OF PHOTOSPHERIC RADIATION ON ABOVE LAYERS OF STAR ATMOSPHERE

O.M.BELOVA¹, K.V.BYCHKOV²

It is investigated the influence of the photosphere thermal radiation on above located pure hydrogen gas. Rates of induced free-bound, bound-bound, and freefree processes are shown to be comparable to ones of the spontaneous processes, if the radiation temperature exceeds 5000 K. Photoexcitation and photoionization from the excited states also play the important role.

Key words: induced process: photoionization: stellar atmospheres

ЛИТЕРАТУРА

- 1. J.C. Brown, Solar Phys., 29, 421, 1973.
- 2. Н.Л. Костюк, С.Б. Пикельнер, Астрон. ж., 51, 1002, 1974.
- 3. В.П.Гринин, Н.А.Катышева, Изв. КрАО, 62, 59, 1980.
- 4. В.П.Гринин, Н.А.Катышева, Изв. КрАО, 62, 66, 1980.
- 5. М.М.Кацова, А.Г.Косовичев, М.М.Лившиц, Астрофизика, 17, 285, 1981.
- 6. J.C. Allred, A.F. Kowalski, M. Carlsson, Astrophys. J., 809, 104, 2015.
- 7. Yu.A.Fadeev, D.Gillet, Astron. Astrophys., 354, 349, 2000.
- 8. Yu.A.Fadeev, D.Gillet, Astron. Astrophys., 420, 423, 2004.
- 9. О.М.Белова, К.В.Бычков, Е.С.Морченко и др., Астрон. ж., 91, 745, 2014, (Astron. Reports, 58, 650, 2014).
- 10. D. Gillet, A.B. Fokin, Astron. Astrophys., 565, 423, 2014.
- 11. Л.А. Вайнштейн, И.И. Собельман, Е.А. Юков, Сечения возбуждения атомов и нонов атомами, М., Наука, 1973.
- 12. Ч.Каули, Теория звездных спектров, М., Мир, 1974.
- 13. О.М.Белова, К.В.Бычков, Астрофизика, 60, 127, 2017, (Astrophysics, 60, 111, 2017).
- 14. К.В.Бычков, Е.С.Морченко, Вестник МГУ Серия 3, Физика Астрономия, 89, 2011.
- 15. L.C.Johnson, Astrophys. J., 174, 227, 1972.

